文章编号: 1672-2892(2012)02-0165-05

频率源设计中参考信号多路功分处理技术

张贵福,黄祥,曾耿华

(中国工程物理研究院 电子工程研究所,四川 绵阳 621900)

要:复杂频率源系统,其参考信号需要进行多路功分处理,该处理会对参考信号的相位噪 摘 声产生影响。文章针对参考信号功分放大带来的相位噪声恶化现象,给予了详细的理论分析,并 结合实例,给出适合工程需要的解决方法,工程实践中验证了该方法的有效性。

关键词:频率源;相位噪声;功分;放大

中图分类号: TN741 文献标识码: A

Power dividing of reference signal in frequency synthesizer

ZHANG Gui-fu, HUANG Xiang, ZENG Geng-hua

(Institute of Electronic Engineering, China Academy of Engineering Physics, Mianyang Sichuan 621900, China)

Abstract: In the complex frequency synthesizer design, the reference signal needs to be divided into several channels, which cause the phase noise of the reference signal degraded. A detailed theoretical analysis of the problem is presented in this paper, and a solution is given, which has been verified in engineering practice.

Key words: frequency synthesizer; phase noise; power dividing; amplification

频率源是通信、雷达、仪器、空间电子设备和电视等电子系统的心脏,其好坏直接影响电子系统的性能指标。 在频率综合技术发展过程中,随着元器件制造工艺不断发展,频率源性能不断提高,目前雷达系统中,低相噪技 术是频率源研究的重点之一。

对于大多数采用相干合成技术实现的频率源[1-2],参考信号的指标是决定其噪声性能好坏的关键因素之一, 因此,参考信号源(一般为晶体振荡器)本身指标和传输过程中指标的变化需要重点探讨。在复杂频率源系统中, 需要参考信号的功能模块常常有多个,每个模块对参考信号的需求各不相同,参考信号需要功分多路。高性能参 考信号功分衰减后,各支路边带调相噪声会落在系统底噪(加性热噪声)之下,从而导致参考信号的相位噪声质量 下降,此外为了满足支路一定的功率需求,必须进行放大处理,而目前市场上常用放大器的相位噪声性能均低于 高性能参考信号的相位噪声性能,这样,功分放大后的参考信号质量就不能满足那些要求较高的模块。

目前国外针对参考信号的多路功分研究得很透彻,并且有相应的低相噪放大器产品,其附加相位噪声接近系 统热噪声;相比之下,国内在此方面研究较少,即使是几个生产晶体振荡器的主要单位,仍没有针对此问题的公 开文献。为不失一般性,本文不单独考虑低相噪放大器。本文针对高性能参考信号在功率分配中出现的相位噪声 恶化现象,给出详细分析,并结合具体实例 表1 三种常用参考源相位噪声对比

给出定量的解决方案。

Table1 Phase noise of three commonly used referen

rabler r hase horse of three commonly used reference sources				
frequency offset/Hz	TCXO dBc/Hz	OCXO/dBc	atomic clock dBc/Hz	
10	<-80	<-90	<-120	
10^{2}	<-110	<-120	<-135	
10^{3}	<-135	<-145	<-150	
10^{4}	<-145	<-160	<-160	
10^{5}	<-155	<-165	<-165	

理论分析

1

1.1 参考信号衰减后相位噪声分析

频率源系统中,能够提供高性能参考信号的产品包括晶体振荡器或者原子钟等,其中晶体振荡器分为普通石 英晶体振荡器、温补晶体振荡器(Temperature Compensate X-tal Oscillator, TCXO)、恒温晶体振荡器 (Oven-Controlled Crystal Oscillator, OCXO)等; 原子钟又包括铷原子钟、铯原子钟等, 普通晶体振荡器指标较差, 一般不用作频率源(尤其是高频、高性能频率源)的参考信号。目前市场几种产品相位噪声指标如表1所示。

从表 1 可以看出,偏离中心频率 在 10 kHz 以上,3 种产品的相位噪声 都很低,尤其是 OCXO 和原子钟,当 信号功率在 0 dBm 附近时,其相位噪 声的绝对值很接近系统底噪(常温下 为-174 dBm/Hz)。

如果参考源的输出信号在传输过 程中遇到功率衰减,则信号自身携带 的噪声和信号一样等比例衰减,而系 统热噪声(系统底噪)却不会衰减。因



此,当参考信号衰减时,自携带噪声随着衰减加大,逐渐接近并低于系统底噪,如图1所示。

从图 1 中可以看出,当信号衰减较大时,其远端边带噪声会"淹没"在系统底噪中,这样,由于在信号远端, 系统噪声高于信号自携带的边带噪声功率,衰减后的信号远端噪声会以系统噪声为主。

设系统底噪(加性热噪声)为高斯白噪声(均值为零,方差为 σ),用 n(t)(包含实部和虚部)表示,信号自带边带 相位噪声为 n_p(t),则信号的完整表达式为:

$$s(t) = r e^{j(wt + n_p(t))} + n(t)$$
(1)

式中 r 为信号的幅度。当信号被衰减时,系统底噪 n(t)的方差不变,即 n(t)的 σ 不会降低,而信号的边带相位噪 声为:

$$r(e^{jn_{p}(t)}-1) = r\left\{jn_{p}(t) + \frac{1}{2}\left[jn_{p}(t)\right]^{2} + L + \frac{1}{N!}\left[jn_{p}(t)\right]^{N} + L\right\} \approx rjn_{p}(t)$$
(2)

当信号功率被衰减时,即信号幅值 r 下降,这样信号自携带边带相位噪声的远端会小于系统底噪(加性热噪声),如图 1。

作为加性噪声的系统底噪(加性热噪声)可以分为:一半调幅(Amplitude Modulation, AM)噪声;一半调相(Phase Modulation, PM)^[3]噪声。两部分噪声功率相等,在常温下,噪声谱密度均为-177 dBm/Hz。在频率源系统中,大部分是相位敏感电路,如分频电路、倍频电路、混频电路等,则 AM 分量被抑制,而 PM 分量将作为相位噪声出现,叠加到原有的相位噪声中,等效为参考信号相位噪声恶化。

1.2 射频放大器中的相位噪声

实践表明,射频放大器内部产生的相位噪声在频率偏移为1Hz~5kHz内,谱密度呈1/f变化,即1/f噪声, 是晶体管的内部噪声源对射频信号直接相位调制产生。一个简单无反馈的射频放大器1/f噪声表达式为^[4]:

$$\alpha(f_{\rm m}) = \alpha(1) - 10 \lg f_{\rm m} \tag{3}$$

式中: f_m 为频率偏移; $\alpha(1)$ 为 $f_m = 1$ Hz时的数值。

对于不同的晶体管类型,如硅、锗、高 $f_{\rm T}$ 、低 $f_{\rm T}$ 、低直流闪烁噪声、高直流闪烁噪声、塑料、密封容器、 双极型、重叠型等, $\alpha(1)$ 最多有 10 dB 的变化范围,取值范围是(-120,-110),一般典型值取-112^[5-6]。为改善 $\alpha(1)$, 只有依靠局部负反馈(如射极负反馈)。目前利用反馈技术,一般可以使得晶体管放大器的 $\alpha(1)$ 增加 30 dB,即 $\alpha(1)=-142$ 。若想进一步提高 $\alpha(1)$,利用高Q材料,甚至可以使 $\alpha(1)$ 的数值优于-155,这种技术在某些高性能的 原子钟、恒温晶振上有所体现^[6]。对于通常所用的射频放大器,其 1/f 噪声可以按照无反馈的类型估算,即 $\alpha(1)=(-120,-110)$ 。

当频偏大于 5 kHz 时, 热噪声占主要部分, 闪烁噪声影响随着频偏增加逐渐降低。在常温下, 热噪声功率谱 密度取-174 dBm/Hz, 其中影响相位噪声的是 PM 分量, 功率占一半^[7]。

2 应用实例

下面以一个实际频率源产品为例,论述上述理论的应用。该频率源部分输出指标见表 2。

除了表 2 所列频点需要参考信号外,还需为整机系统提供 1 路时钟信号和为频率源内部数字模块提供数路时 钟信号,共有多于 7 个模块需要参考信号。产品选用 100 MHz 恒温晶振作为参考信号,其指标见图 2。

该恒温晶振(OCXO)输出功率为9dBm,因此其相位噪声的绝对值如图3所示。



2.1 功分衰减后参考信号相位噪声分析

从图 3 中可以看出, 在偏离中心频率 10 kHz 处, 噪声功 率谱密度大约为-161 dBm/Hz,如果以常温状态为准,系统底 噪为-174 dBm/Hz, 二者相差 13 dB。这意味着, 只要参考信 号被衰减大于 10 dB, 该处的噪声功率谱密度就低于系统底 噪,并且需要强调的是,如果参考信号衰减后是送到相位敏 感系统,且对幅度不敏感(如加了限幅器、鉴相器等),则参考 信号衰减 16 dB 后与系统底噪相等。

根据该频率源指标要求,2个最高输出频率与参考信号 100 MHz 不是整数倍关系,需采用双环实现,2个双环电路采用同一个高频率的频标信号。为了保证频标信号质 量,其参考信号尽量由恒温晶振直接提供,不衰减,故采用了10dB耦合器对参考信号进行分路,主路输送给频 标信号产生电路,衰减约1dB,副路衰减约10dB,然后分成6路,送给其他支路,功分框图见图4。

根据现有器件,6路功分能够带来的最大衰减约为8dB,考虑5dB余量(一般支路信号需要放大,而放大器 存在一定的噪声系数),每个支路有 18 dB 的功率衰减。因此,噪声功率谱密度小于-154 dBm 的频段,都将淹没 于系统底噪,对应图3的1kHz以外频段。本例中,功分后的各个支路信号功率为-14dBm。

根据上述数据,只考虑系统底噪 PM 分量(占总底噪功率的一半),则支路的相噪基底相对值变为-163 dBm/Hz, 这样各个支路相位噪声如图 5 所示。

2.2 放大后参考信号相位噪声分析

常用的射频放大器都不采用反馈技术。根据图 2 和式(3), 放大器带来的相位噪声在偏离载频 1 kHz 以外高于参考信号本 身自带相位噪声,因此当参考信号输出功率较高,自带相位噪 声基底的绝对值大于系统底噪,且满足数个子模块对参考信号 功率需求时,不必放大;相反,参考信号输出功率很低,此时 就要考虑放大问题。

根据图 2 所示指标,考察射频放大器对参考信号相位噪声 的影响。根据式(3),在1kHz 处,为-142dBc/Hz;在5kHz 处,为-149 dBc/Hz。取放大器的噪声系数为 5 dB,则频偏大 于 5 kHz 的热噪声底线为-169 dBm/Hz, 调相分量为-172

dBm/Hz。假定参考信号相位底噪绝对值(对应图 3 为-163.5 dBm/Hz)接近系统底噪(热噪声)-174 dBm/Hz, 对应参 考信号的功率为-1.5 dBm,则图 2 所示的参考信号放大后相位噪声变为图 6。





图 4 参考信号功分网络



一般锁相环环路带宽在几百 kHz 以内,比较图 5 和 图 6 可以看到,在环路带宽内图 5 指标优于图 6,故参 考信号选用先功分后放大处理方式,放大后各支路相位 噪声由图 5 变为图 7。

如果参考信号需要分路更多,或者参考信号源本身 输出功率很低,导致图 5 指标在环路带宽内劣于图 6, 则需要按如下步骤处理:

a) 确定初次功率分配路数, 使图 5 指标优于图 6(所 需带宽内);

b) 对每个支路信号进行功率放大;

c) 再次对每个支路进行功分;

d) 每个支路再重复上述步骤。

根据这些步骤安排无源功分和放大器的布局,确保设 计出最优的功分、放大网络。

3 试验结果

本文所举实例最终结果见表 3,测试仪器为 Agilent 公司的 E5052B 和 E5053A。表 3 所示结果包含了频率源内部 其他器件的影响,包括倍频器、鉴相鉴频器、运算放大器 和电源等影响,部分电路影响超过了参考信号的功分放大 电路。



Fig.6 Phase noise of each reference signal branch after amplification 图 6 直接放大后支路相位噪声



Fig.7 Phase noise of each reference signal branch after power divider and amplification 图 7 功分放大后支路相位噪声

表 3 测试结果

Tables Measure results						
channels	centre frequency/MHz	output power/dBm	phase noise/dBc/Hz@10 kHz	spurious suppression/dBc		
1	14 480	10	-101	52		
2	13 100	10	-99.3	58		
3	others	>10	<-110	60		

4 结论

本文给出了一种实用的参考信号功分放大技术,并通过工程实例进行验证。该技术随着参考信号功分路数增加而变得愈发重要,当频率源内部需要参考信号的功能模块数达到十个乃至数十个时,按照本文所述方法可设计出较为优化的功分放大网络。

当某些模块同时要求很高的参考信号功率和相位噪声指标时,如梳状谱发生器等产品,可以选择带负反馈的 放大器或者放大后接窄带的滤波器(如晶体滤波器、声表面波滤波器等)改善参考信号指标。

总之,在高性能参考信号多路分配时,要同时关注系统底噪、有源器件噪声、参考信号功率等因素,合理规 划,方能设计出符合系统需求的分配网络。

参考文献:

- [1] 廖梁兵,邓贤进,张红雨. 低相噪毫米波频率合成器设计[J]. 信息与电子工程, 2010,8(1):33-35.
- [2] 邓贤进,李家胤,张健.C波段频率合成器设计[J]. 电讯技术, 2006,46(3):22-23.

[3] Halford D, Wainwright A E, Barnes J A. Flicker Noise of Phase in RF amplifiers and Frequency Multipliers: Characterization, Cause, and Cure[C]// Proceeding of 20th Annual Symposium on Frequency Control. Washington:[s.n.], 1968:340-341.

[4] Halford D. Phase Noise in RF amplifiers and Frequency Multipliers[C]// U.S. Government Memorandum to J A Bames, Washington:[s.n.], 1967.

(下转第183页)